

通用（双晶体管）

IMT4

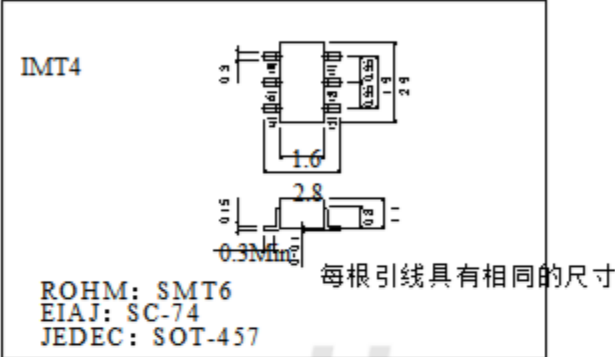
特征

- 1) 两个2SA1514K芯片采用AMT封装.
- 2) 高击穿电压.

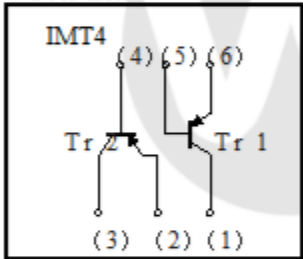
包装，标记和包装规格

部件号	IMT4
包	SMT6
印记	T4
码	T108
基本订购单位（件）	3000

外形尺寸（单位：mm）



等效电路



绝对最大额定值（大= 25 C）

参数	符号	范围	单元
集电极基极电压	V CBO	-120	V
集电极发射极电压	V CEO	-120	V
发射极 - 基极电压	V EBO	-5	V
集电极电流	我 C	-50	嘛
功耗	个人计算机 300（总计）		毫瓦 *
结温	TJ	150	C
储存温度	TSTG	-55到+150	C

*每个元件不得超过200mW.

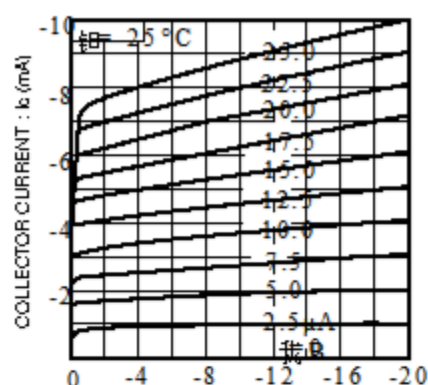
电气特性（Ta = 25 C）

参数	符号	闭	典型	最大	单元	条件
集电极基击穿电压	BV CBO	-120	-	-	V	我 50μA
集电极发射极击穿电压	BV CEO	-120	-	-	V	我 -1mA
发射极击穿电压	BV EBO	-5	-	-	V	我 50μA
收集器截止电流	我是 CBO	-	-	-0.5	μA	V EB100V
发射极截止电流	我是 EBO	-	-	-0.5	μA	V EB1V
直流电流传输率	h FE	180	-	820	-	V EB6V, I C -2mA
过渡频率	f T	-	140	-	兆赫	V EB12V, I E = 2mA, f = 100MHz
集电极发射极饱和电压	V CE (sat)	-	-	-0.5	V	我 C-10mA / -1mA

*设备的转换频率.

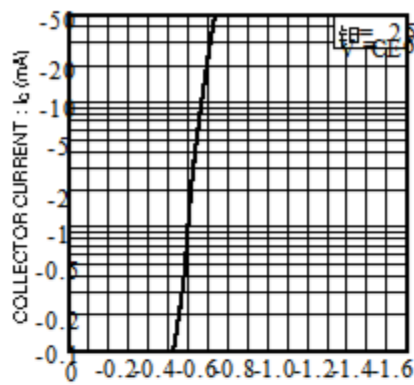
晶体管

电气特性曲线



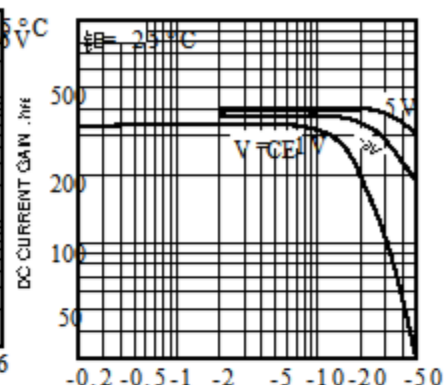
收集器到发射器电压: V_{CE} (V)

图1地面发射极输出特性



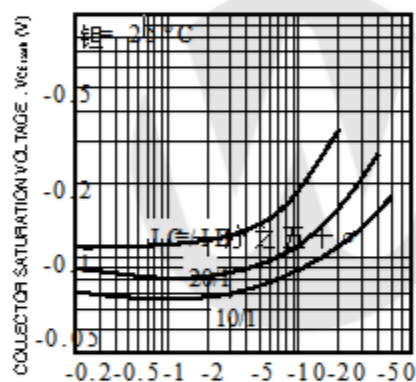
基于发射极电压: V_{BE} (V)

图2地面发射体传播特点



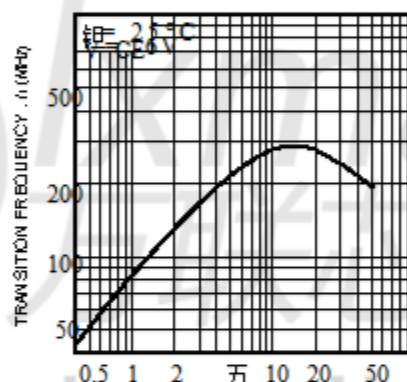
收集器电流: I_C (嘛)

图3直流电流增益与集电极电流的关系



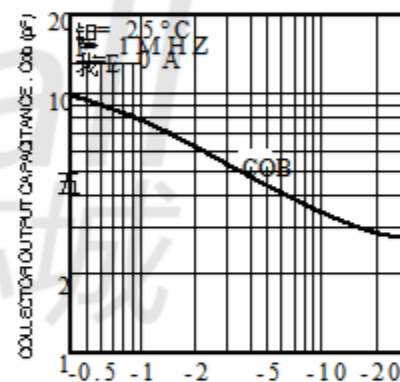
收集器电流: I_C (嘛)

图4集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流



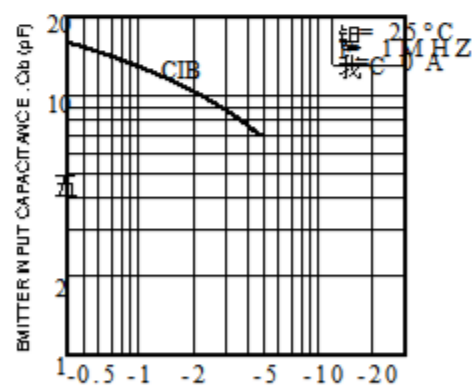
发射机电流: I_E (嘛)

图5过渡频率与发射极电流



收集器与基准电压: V_{CB} (V)

图6集电极输出电容 vs. 集电极基极电压



发射器至基准电压: V_{EB} (V)

图7发射极输入电容与发射极 - 基极电压

笔记

- 本文档的技术内容页面不得以任何形式复制或传播
意味着未经ROHM CO., LTD事先许可。
- 此处所述的内容如有更改，恕不另行通知。规格
本文档中描述的产品仅供参考。因此，在实际使用时，请提出要求
该规格将分开交付。
- 这里包含的应用电路图和电路常数是标准的例子
使用和操作。设计电路时请注意外围条件
并确定该组中的电路常数。
- 任何数据，包括但不限于此处描述的应用电路图信息
仅用于说明此类设备，而不是作为此类设备的规格说明。ROHM
有限公司。对任何使用此类设备的行为不得有任何侵权行为不承担任何保证
第三方的知识产权或其他所有权，并进一步，不承担任何责任
任何此类侵权行为的性质，或与之相关或与之相关或与之相关的任何性质
到这些设备的使用。
- 在出售任何此类设备后，除买方有权自行使用此类设备外，转售或以其他方式转售
否则处置相同的，没有明示或暗示的权利或执照或商业
利用其所拥有或控制的任何知识产权或其他专有权利
- 罗姆株式会社授予任何此类买方。
- 本文档中列出的产品不是抗辐射设计。

本文档中列出的产品旨在与普通电子设备或设备一起使用
(如视听设备，办公自动化设备，通讯设备，电器
电器和电子玩具)。

如果您打算将这些产品用于需要极高水平的设备或设备
可靠性和故障会直接危及人的生命(如医疗器械，
运输设备，航空航天机械，核反应堆控制器，燃料控制器等
安全装置)，请务必事先咨询我们的销售代表。

关于日本的出口管制令

本文所述的产品是出口贸易管制附件1(第16项)中的受管制物品
在日本订购。

如果是日本出口，请确认它是否适用于“客观”标准或“知情”(由MITI条款)
以“抓住所有对不扩散大规模毁灭性武器的控制”为基础。